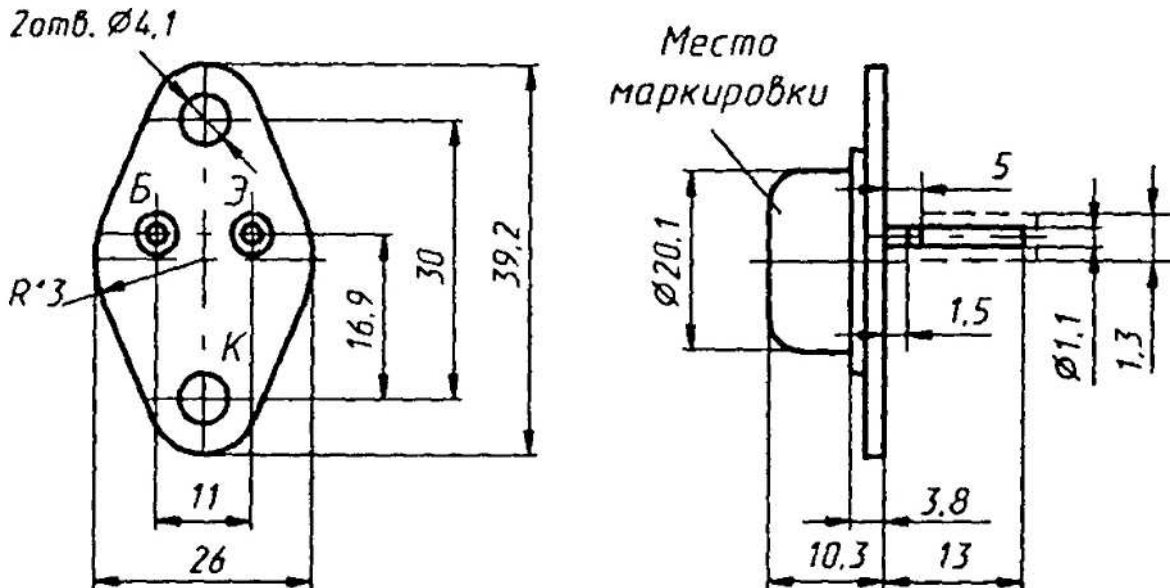


## 2Т812А, 2Т812Б, КТ812А, КТ812Б, КТ812В

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* импульсные. Предназначены для применения в импульсных и переключательных устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 20 г.

2Т812(А, Б) КТ812(А-В)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

$T_K = +25\text{ }^\circ\text{C}$ :

$U_{КЭ} = 3\text{ В}$ ,  $I_K = 8\text{ А}$  для 2Т812А,

2Т812Б ..... 5...15\*...30\*

$U_{КЭ} = 2,5\text{ В}$ ,  $I_K = 8\text{ А}$  для КТ812А,

КТ812Б, не менее ..... 4

$U_{КЭ} = 5\text{ В}$ ,  $I_K = 5\text{ А}$  для КТ812В ..... 10...80\*...125\*

$T_K = +125\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $U_{КЭ} = 3\text{ В}$ ,  $I_K = 5\text{ А}$  для

2Т812А, 2Т812Б, не менее ..... 4

$T_K = -60\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $U_{КЭ} = 3\text{ В}$ ,  $I_K = 8\text{ А}$  для

2Т812А, 2Т812Б, не менее ..... 3

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при  $f = 1\text{ МГц}$ ,  $U_{КЭ} = 10\text{ В}$ ,

$I_K = 0,2\text{ А}$  ..... 3,5...6,5\*...8,4\*

Граничное напряжение при $I_K = 0,1$ А, $I_{K \text{ нас}} = 300$ мА, $L = 40$ мГн.....	350...450*... 650* В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 8$ А, $I_B = 1,6$ А .....	1*...1,35*... 2,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 8$ А, $I_B = 1,6$ А .....	1,8*...2,2*... 2,5 В
Время спада при $U_{KЭ} = 250$ В, $U_{БЭ} = 4$ В, $I_K = 5$ А, $I_B = 2,5$ А .....	0,22...0,6*... 1,3 мкс
Обратный ток коллектора, не более:	
$T = +25$ °С, $U_{КБ} = 700$ В для 2Т812А, КТ812А, $U_{КБ} = 500$ В для 2Т812Б, КТ812Б, $U_{КБ} = 300$ В для КТ812В.....	5 мА
типовое значение.....	0,5* мА
$T = +125$ °С, $U_{КЭ} = 400$ В для 2Т812А, $U_{КБ} = 300$ В для 2Т812Б .....	10 мА
$T = -60$ °С, $U_{КБ} = 500$ В для 2Т812А, $U_{КБ} = 400$ В для 2Т812Б .....	10 мА
Обратный ток эмиттера не более:	
$U_{ЭБ} = 6$ В для 2Т812А, 2Т812Б .....	50 мА
типовое значение.....	5* мА
$U_{ЭБ} = 7$ В для КТ812А, КТ812Б, КТ812В ....	150 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 100$ В .....	70*...85*... 100* пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор—эмиттер <sup>1</sup> при $R_{БЭ} = 10$ Ом, $t_{и} \leq 20$ мкс, $t_{ф} \geq 3$ мкс, $Q \geq 3$ , $T_K = -40...85$ °С для 2Т812А, 2Т812Б и $t_{и} \leq 1$ мс, $Q \geq 10$ или $t_{и} \leq 50$ мкс, $Q \geq 2$ для КТ812А, КТ812Б, КТ812В:	
2Т812А, КТ812А .....	700 В
2Т812Б, КТ812Б.....	500 В
КТ812В .....	300 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер <sup>1</sup> при $R_{БЭ} = 10$ Ом, $t_{и} \leq 50$ мкс, $t_{ф} \geq 0,3$ мкс, $Q \geq 2$ , $T = -40...+85$ °С .....	
	350 В
Постоянное напряжение база—эмиттер:	

2Т812А, 2Т812Б .....	6 В
КТ812А, КТ812Б, КТ812В.....	7 В
Постоянный ток коллектора:	
2Т812А, 2Т812Б .....	10 А
КТ812А, КТ812Б, КТ812В.....	8 А
Импульсный ток коллектора:	
2Т812А, 2Т812Б:	
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 10$ .....	17 А
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 2$ .....	12 А

<sup>1</sup> При понижении температуры корпуса от  $-40$  до  $-60$  °С и при повышении от  $+85$  до  $+100$  °С  $U_{кз, и, макс}$  линейно снижается до 500 В для 2Т812А и до 400 В для 2Т812Б; при повышении температуры корпуса от  $+100$  до  $+125$  °С  $U_{кз, и, макс}$  линейно снижается до 400 В для 2Т812А и до 300 В для 2Т812Б.  
 При  $t_{ф} \geq 0,3$  мкс и понижении температуры корпуса от  $-40$  до  $-60$  °С и при повышении температуры от  $+85$  до  $+125$  °С  $U_{кз, и, макс}$  снижается до 300 В.

КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $t_{и} \leq 1$ мс, $Q \geq 10$ или $t_{и} \leq 50$ мкс, $Q \geq 2$ .....		12 А	
Постоянный ток базы:			
2Т812А, 2Т812Б .....		4 А	
КТ812А, КТ812Б, КТ812В.....		3 А	
Импульсный ток базы:			
2Т812А, 2Т812Б:			
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 10$ .....		7 А	
$t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 2$ .....		5 А	
КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $t_{и} \leq 1$ мс, $Q \geq 10$ или $t_{и} \leq 50$ мкс, $Q \geq 2$ .....		4 А	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> 2Т812А, 2Т812Б при $T_{к} = -60...+50$ °С и КТ812А, КТ812Б, КТ812В при $T_{к} = -45...+50$ °С .....			50 Вт
Температура р-п перехода .....		$+150$ °С	
Температура окружающей среды:			
2Т812А, 2Т812Б .....	$-60... T_{к} =$ $= +125$ °С		
КТ812А, КТ812Б, КТ812В.....	$-45... T_{к} =$ $= +85$ °С		

<sup>1</sup> При повышении температуры корпуса выше  $+50$  °С  $P_{к, макс}$  снижается в соответствии с формулой

$$P_{к, макс} = (T_{п} - T_{к})R_{т(п-к)}, \text{ Вт.}$$

Значение  $R_{т(п-к)}$  определяется из области максимальных режимов.

При применении транзисторов в каскадах строчной развертки телевизоров допускается эксплуатация их с коэффициентом загрузки, равным единице по  $U_k$  и  $I_k$ ; при этом температура корпуса не должна превышать  $+100\text{ }^\circ\text{C}$ .

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 5 мм, температура пайки не выше  $+250\text{ }^\circ\text{C}$  в течение 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.